

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stückz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364 - 506 - 1	
2				
3	39	Transistor Halter	2587 - 676 - 1	
4				
5				
6				
7		Schlüssel Einbau	2587 - 680 - 1	
8				
9				
10	39	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 32	für Transistor
11	39	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 132	für Transistor
12	39	Jsolierschlauch	2699 - 329 - 232	für Transistor
13				
14		Stromlaufplan	3361 - 459 - 1	
15		Bauschaltplan Bl.1	3461-459 - 1	
16				
17		Legeliste Bl.1	3861-459 - 1	
18				
19				
20				
21				
22		Abbiegung von Bauelementen in Senkrechtbauweise	24 - 5459 -.....	
23				
24				
25	276	Lötstift	2685-592-1	Einbau nach 24 - 5436 - 1
26				
27		Beschriftung	SA 7-07	

73 - 542

**SA 7-07**  
 Steuerung Akkumulator  
 Sammelkarte



Blatt  
**3E61- 459 - 1 1...5**

V6421-118	b	20.10.59	AIF 597	Kraft	Ma	
	a	20.7.59	NIF 597	Zim		
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.	

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D1	1	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	05201
D2	1	"	L8011	WN 5457	07201
D3	1	"	L8011	WN 5457	05201
D4	1	"	L8011	WN 5457	07201
D5	1	"	L8011	WN 5457	05201
D6	1	"	L8011	WN 5457	05201
D7	1	"	L8011	WN 5457	07201
D8	1	"	L8011	WN 5457	05201
D9	1	"	L8011	WN 5457	07201
D10	1	"	L8011	WN 5457	05201
D11	1	"	L8011	WN 5457	05202
D12	1	"	L8011	WN 5457	05202
D13	1	"	L8011	WN 5457	05202
D14	1	"	L8011	WN 5457	10202
D15	1	"	L8011	WN 5457	05202
D16	1	"	L8011	WN 5457	05202
D17	1	"	L8011	WN 5457	07202
D18	1	"	L8011	WN 5457	05202
D19	1	"	L8011	WN 5457	05202
D20	1	"	L8011	WN 5457	05202
D21	1	"	L8011	WN 5457	07202
D22	1	"	L8011	WN 5457	05202
D24	1	"	L8011	WN 5457	07202
D25	1	"	L8011	WN 5457	05202
D26	1	"	L8011	WN 5457	05202
D27/0...4	5	"	L8011	WN 5457	05261

»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

73-542

SA 7-07  
Steuerung Akkumulator

Freimaßtoleranzen	Maßstab
Gez.	



Blatt  
3E61 - 459 - 1  
2...

F. Form 20/0 0,1-77

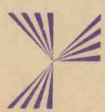

Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg Ges.
b	20.10.59	AIF 597-1	Kraft	Ma	
a	20.7.59	NIF 597	Zim		

\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGG). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D28/0...2	3	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	05261
D29/0...3	4	"	L8011	WN 5457	05261
T1	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T2	1	"	A30	WN 5444	
T3	1	"	A30	WN 5444	
T4	1	"	A30	WN 5444	
T5	1	"	A30	WN 5444	
T6	1	"	A30	WN 5444	
T7	1	"	A30	WN 5444	
T8	1	"	A30	WN 5444	
T9	1	"	A30	WN 5444	
T10	1	"	A30	WN 5444	
T11	1	"	A30	WN 5444	
T12	1	"	A30	WN 5444	
T13	1	"	A30	WN 5444	
T14	1	"	A30	WN 5444	
T15	1	"	A30	WN 5444	
T16	1	"	A30	WN 5444	
T17	1	"	A30	WN 5444	
T18	1	"	A30	WN 5444	
T19	1	"	A30	WN 5444	
T20	1	"	A30	WN 5444	
T21	1	"	A30	WN 5444	
T22	1	"	A30	WN 5444	
T23	1	"	A30	WN 5444	

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 7 - 07 Steuerung Akkumulator	
Gez					
 <b>STANDARD ELEKTRIK LORENZ</b>		3E61 - 459 - 1		Blatt	
				3..	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
a	20.7.59	NIF 597	Zim		

»Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der G.M.-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.«

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stückz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
T24	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T26	1	"	A30	WN 5444	
T27	1	"	A30	WN 5444	
T28	1	"	A30	WN 5444	
T29	1	"	A30	WN 5444	
T30	1	"	A30	WN 5444	
T31	1	"	A30	WN 5444	
T32	1	"	A30	WN 5444	
T33	1	"	A30	WN 5444	
T34	1	"	A30	WN 5444	
T35	1	"	A30	WN 5444	
T36	1	"	A30	WN 5444	
T37	1	"	A30	WN 5444	
T38	1	"	A30	WN 5444	
T39	1	"	A30	WN 5444	
T40	1	"	A30	WN 5444	
R1	1	Schichtwiderstand	10k/2/2	WN 5121	05260
R2	1	"	5k/2/2	WN 5121	05260
R3	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R4	1	"	10k/2/2	WN 5121	07260
R5	1	"	5k/2/2	WN 5121	05260
R6	1	"	5k/2/2	WN 5121	05260
R7	1	"	5k/2/2	WN 5121	05260
R8	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260

73-542

IF Form 20/O 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 7 - 07 Steuerung Akkumulator	
Gez					
b	20.10.59	AIF597-1	Kreft	Ma	3E61 - 459 - 1
a	20.7.59	NIF597	Zm		
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.



Blatt 4...

